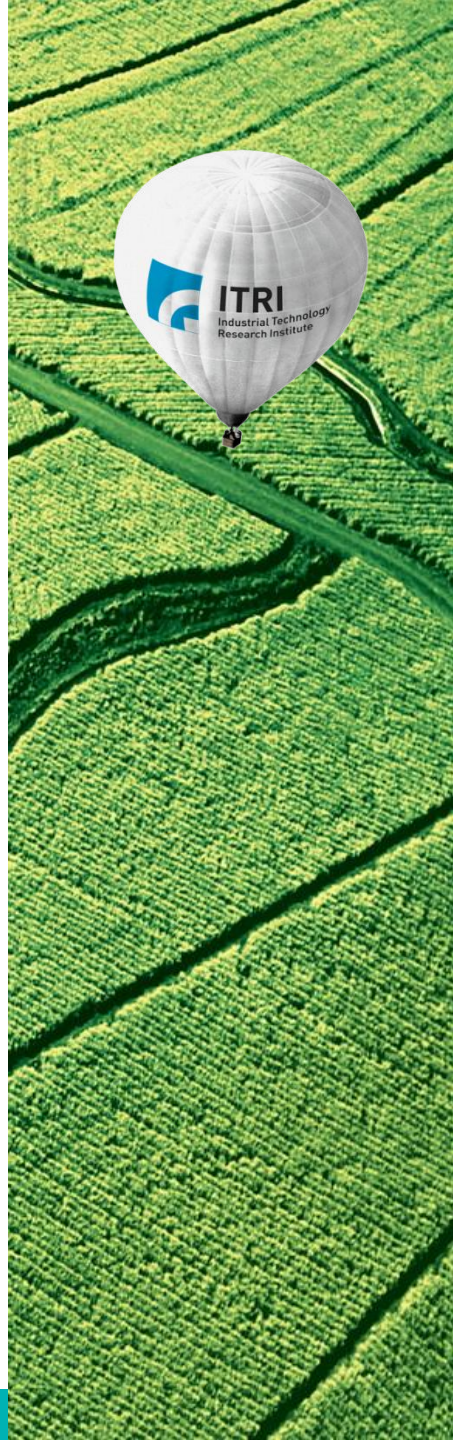
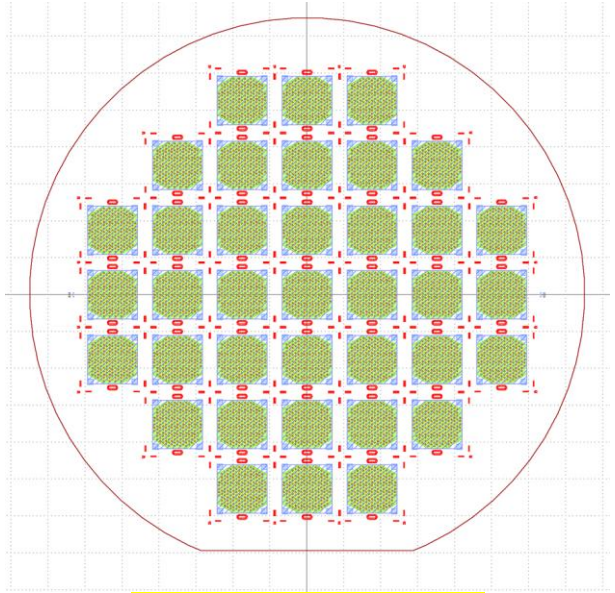
工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute



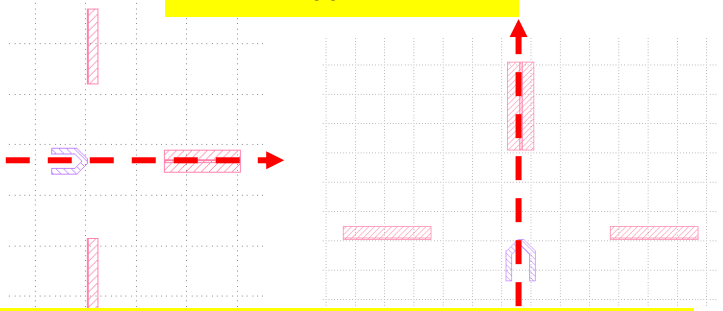
OCS Mirror模組與驅動模組切割委託加工

2026.11.24

©工業技術研究院 權利所有。



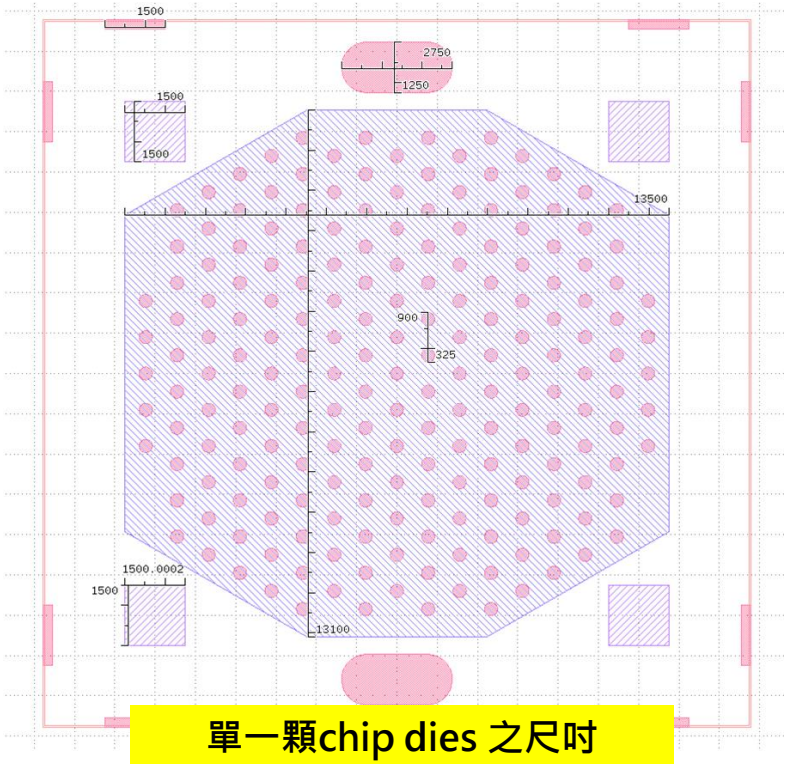
佈局



外圍有設計「光標」，可依中心切割

17500 um
(17.5mm)

17500 um
(17.5mm)



單一顆chip dies 之尺吋

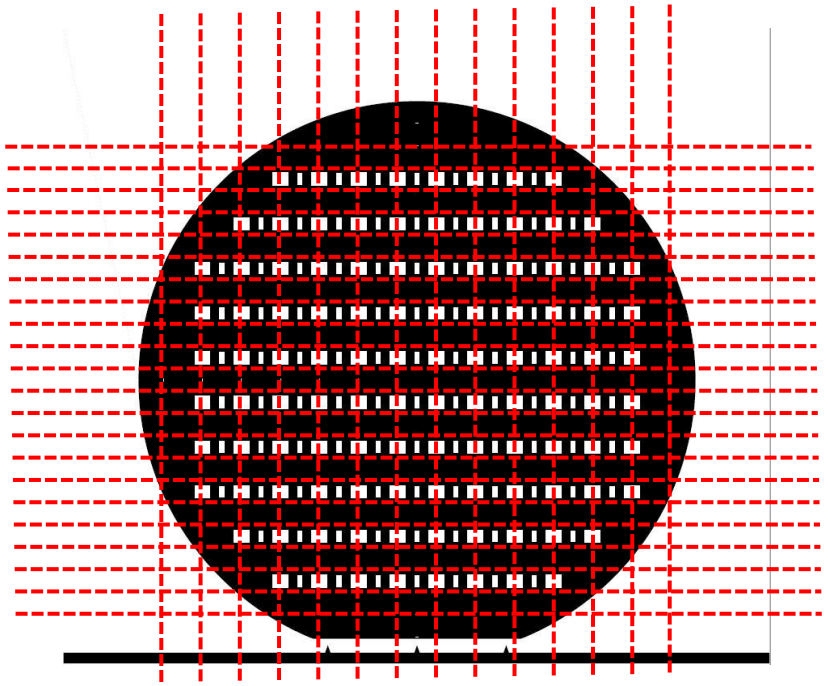


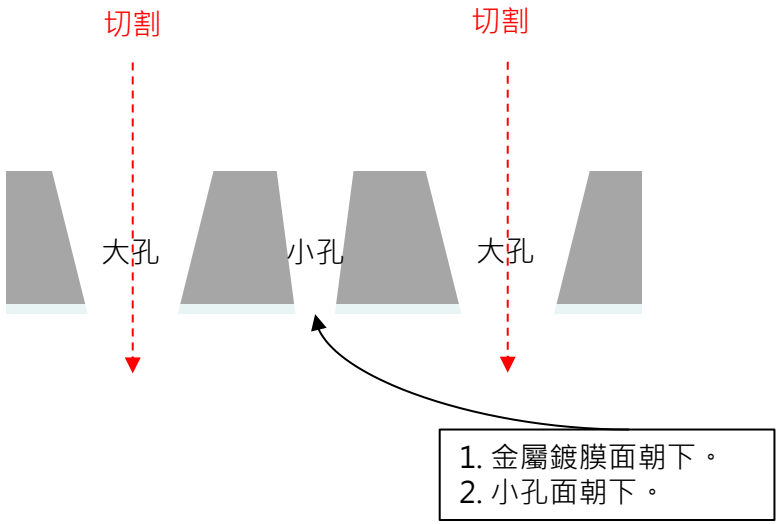
8角型及有4顆凸點的面請朝上

委託項目	晶片型號	製程規格	片數	備註
切割 Dicing Unit cell尺寸： 17500 um x 17500 um (17.5mm x 17.5mm)	8inch Silicon 厚度：350um	• 如上圖	1SET	● 切割後，請協助取dies 並移放至另一張 Tape + 切割環。 ● 請依對位光標進行切割。 ● 正面請使用離型膜保護。

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。





委託項目	晶片型號	製程規格	片數	備註
切割 Dicing saw	6-inch 1. slit mask 100um (1pcs) 2. Slit mask 60um (1pcs)	依定位點切割	1set	1.隨貨附切割固定環 2.此案請安排使用貴公司「舊型」設備執行。

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。